

Изобретение относится к технике и технологии оксидных полупроводников, в частности к способам получения сенсоров *n*-бутанола на основе гетероперехода ZnO-Al₂O₃.

Способ, согласно изобретению, включает нанесение наноструктурной пленки ZnO на стеклянную подложку методом химического синтеза из раствора, нанесение на пленку ZnO пленки Al₂O₃ толщиной 17...20 нм, методом вакуумного термического испарения триизопрпилата алюминия (Al(C₃H₇O)₃) при температуре подложки 450°C, нанесение на пленку Al₂O₃ меандрообразных омических контактов Au-Cr, быструю фотонную обработку полученной структуры при температуре 650°C в течение 30 с.

П. формулы: 1

Фиг.: 3